

1.

1. ~
2. 낸드형 플래시 메모리에 전압을 걸어주면 전자가 소스 영역과 드레인 영역 사이를 이동할 수 있다.
 - 컨트롤 게이트에 양의 전압이 아닌 음의 전압을 걸면 전자가 이동할 수 x, p층에 전압을 거는지 컨트롤 게이트에 전압을 거는지도 명시x >>>틀린선지
3. ~
4. **SSD는 물리적인 부품을 사용해 정보를 저장한다.**
 - 낸드형 플래시 메모리가 물리적인 부품이 아니면 뭐임..?, 지문에서 명시한 것은 SSD가 물리적으로 움직이는 부품을 쓰지 않았다는 것
5. ~

2.

1. ~
2. **컨트롤 게이트에 전압이 걸리면 소스 영역과 드레인 영역 사이를 전자가 이동할 수 있다.**
 - 이것도 1번 문제와 마찬가지로 음의 전압이 걸리면 전자 이동 불가능
3. 컨트롤 게이트는 산화막 위에 금속이 쌓인 형태이다.
 - ...는 바디 위에서 순서대로 산화막과 금속이 쌓여 만들어진... <<<바디 위에 산화막이 쌓이고 그 위에 금속이 쌓였다는 뜻이었는데 이걸 서술 오류인가봐요
4. 4. MOSFET 반도체의 바디는 P형 반도체로만 이루어져 있다.
 - 사실 오답을 여기로 유도했었음,,, (3문단) 바디는 P층으로 이루어짐, 양 쪽에 N형 반도체로 이루어진 소스/드레인 영역이 위치 -> '바디'에 소스/드레인 영역이 포함되지는 x
5. ~

3.

1. ~
2. 적은 양의 정보를 처리할 때는 NOR형 플래시 메모리가 낸드형 플래시 메모리보다 더 유리할 수 있겠군.
 - 3번 선지와 같은 상황에서는 NOR형 플래시 메모리가 낸드형 플래시 메모리보다 유리하겠죠..? 혹시 이거 클레임 들어올까봐 마지막에 문장 끝을 가능성 물어보는 진술로 바꾸긴 했는데...
3. 프로그램을 저장해둔 상태에서 그 프로그램을 읽는 작업이 반복될 때는 NOR형 플래시 메모리가 낸드형 플래시 메모리보다 더 유리하겠군.
 - 그쵸..? 아무래도 읽기만 할 때는 NOR형이 낸드형보다 더 빠르니까...
4. 플래시 메모리를 읽고 쓰는 용도로 사용할 때는 낸드형 플래시 메모리가 NOR형 플래시 메모리보다 더 유리하겠군.
 - 읽고 쓰는 용도로 사용하는데 읽기는 NOR형이 소폭 빠르지만 쓰기가 NOR형이 현저히 느리므로,,, 낸드형이 더 유리합니다
5. **NOR형 플래시 메모리와 낸드형 플래시 메모리의 크기가 같을 때, NOR형 플래시 메모리의 저장 용량이 낸드형 플래시 메모리의 저장 용량보다 클 수는 없겠군.**
 - 셀을 항상 최대로 집적시키는 건 아니므로,,, 같은 크기일 때 낸드형에 더 적은 양의 셀이 들어간다면 NOR형이 저장 용량이 더 클 수 있습니다
 - 다시 보니까 이거 보기를 좀 잘못 썼네...